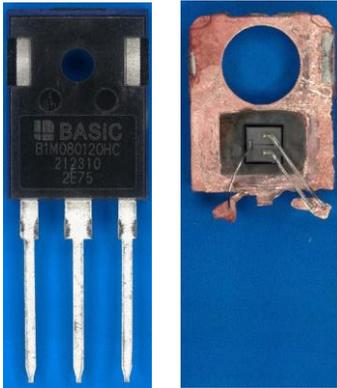


中国製SiC MOSFET構造解析 3社概要レポート (BASIC Semiconductor, INVENTCHIP Technology, SASTC)



パッケージ写真 (BASIC)



チップ写真 (BASIC)

製品概要

SiCパワーデバイスは、EV市場の拡大もあり、今後毎年2桁成長を達成すると予測されている。中でも中国の成長には今後注目する必要がある。

中国では、BASiC SemiconductorやINVENTCHIP TechnologyはすでにSiC MOSFETを製造し発売している。またBYD MicroelectronicsはSiC MOSFETの開発に成功している。本レポートは、中国メーカー3社のSiC MOSFETの概要を提供し、先端SiCメーカーと比較することで、その実力を明らかにします。

解析製品

- ・BASIC Semiconductor B1M080120HC 1200V SiC MOSFET 42A 80mΩ
- ・INVENTCHIP Technology IV1Q12080T3 1200V SiC MOSFET 42A 80mΩ
- ・SASTC SA1M12000065D 1200V SiC MOSFET 40A 65mΩ

レポート内容、価格

- ・パッケージ外観、X線観察
- ・SiC MOSFET チップ観察
- ・SiC MOSFET 断面解析:セル構造、平面解析:活性領域AA
- ・電気特性評価(ゲートリーク電流、 I_{ds} - V_{ds} 温特)
- ・他社との比較(ローム、WLFSPD、Infineonなど先端SiCメーカーとの比較)

レポート価格:60万円(税別) 7/29リリース予定